シンクロサイクロトロンの周波数広帯域無同調型高周波加速装置の可能性

佳元壮一郎

大阪大学核物理研究センター

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 10-1

概要

並列LCR 共振回路を橋絡 T 字型全域通過網回路(以下橋 絡 T 回路)に組込むと、共振周波数が時間的に一定であるに も拘らず、この共振回路の両端に発生する電圧は周波数帯 域特性を示す。橋絡 T 回路のこの特性を活用して、固定周 波数のサイクロトロンのための高周波加速空洞に組込ん で、加速電圧に周波数帯域特性を持たせることにより、シ ンクロサイクロトロンのための高周波加速装置として、高 電力、周波数掃引の繰返しの速い、高周波加速装置の開発 研究に取組んでいる。その研究の第一段階目として、加速 電圧を昇圧する、サイクロトロンの高周波空洞と増幅器間 のカップリング回路を、トランスで模擬したときの、弱電 回路のモデルを製作し、各部の電圧電流特性の測定を行っ た。本論文では、その測定に基づいて、新たな方式による 可能性と問題点について報告する。

1 序論

シンクロサイクロトロンは、時間的に一定の磁場の下で、 荷電粒子の周回周波数が軌道半径の増加に従い変化する ように磁場分布を定め、それに高周波加速周波数を変調さ せ、同期加速する加速器であり、磁場を最外周まで利用で きるので、加速エネルギーを、サイクロトロンよりも、高 く出来ると言う特長を持つ。

この加速器は 1940 年代にかけて弱集束サイクロトロン の高エネルギー化の目的で一時期建設されたが、その後、 当時のシンクロサイクロトロンの高周波加速装置では周 波数掃引の繰返しが 50~80(/sec)と遅く、平均ビーム強度を 高く出来なかったことや、強集束サイクロトロンが登場し たことにより衰退した。しかし、最近の高周波加速装置の 技術的な進歩により、周波数掃引の繰返しが速く出来るよ うになり、ビーム強度を高く出来るので、この加速器の見 直しが始められている。 [1]

我々RCNPでも、シンクロサイクロトロンの基礎研究に 着手し、そこで、今までの高周波加速装置とは異なり、橋 絡T字型全域通過網回路をサイクロトロンの高周波加速装 置に適用することを考えた。

この橋絡 T 回路は、通常の並列 LCR 共振回路を広帯域 化した場合に比べ、広帯域、高電力に出来ることが特長で、 これまでに、この回路はシンクロトロンの無同調型高周波 加速空洞にも適用されている。[2]

ところで、サイクロトロンの高周波加速装置では、電圧 を昇圧するので、入力側から大電流が流れ、電力フィーダ ーが過熱する可能性がある。これを避けるために、橋絡 T 回路を複数組合せて、電流を分散化するような方法を考え なくてはならない。しかし、その構造は複雑な回路となり、 まだ検討中である。しかし、本論文ではそのような複雑な 回路へ進むための第一段階目として、まず加速電圧を昇圧 する、サイクロトロンの高周波加速空洞と増幅器間のカッ プリング回路を、トランスで模擬したときの、単一の橋絡 T回路の性能を、弱電回路によるモデルで検証することに した。

2 橋絡 T 字型全域通過網の原理

橋絡 T 回路は、図 1 のような回路である。これらの回路 網はキルヒホッフの法則を用いて定式化することが出来 る。回路網のインピーダンスと電圧の関係式と全域通過の 条件 V=IR から、一定値 R になるようにインピーダンスを 定めると、以下のような特殊な条件が導き出される。

$$Z_{2} = \frac{R^{2}}{2Z_{1}}, \quad Z_{3} = 4Z_{1}$$
 (1)

すなわち、これを満たせば、この回路全体の入力インピ ーダンスは加速周波数に依らず抵抗 R となり、インピーダ ンスマッチングが実現でき、市販の高周波増幅器で励振可 能である。さらに、(1)の条件の下で、図1のインピーダン ス Z1 を並列 LC 共振回路としたとき、入力電圧 V に対す る、加速ギャップにあらわれる電圧(加速電圧)との比と、 加速周波数の関係は図2のように広帯域特性を示す。従っ て、入力側の周波数を変化させると、加速電圧側の周波数 も変化させることができる。

また、この橋絡T回路は同調型のような共振回路の共振 周波数を変えて、粒子の周回周波数に同調させるような複 雑な構造、制御系が不要なので、比較的簡素化された回路 であり、LCR 並列共振回路を広帯域化した場合に比べて、 抵抗が図1のように加速空洞の外側なので、抵抗を増加さ せると、電力を増加させることが出来る。

ところで、(1)の条件の下で、このような特性を持つ橋絡 T回路を高周波加速装置に適用したときのインピーダンス Z1、Z2、Z3はLCR共振回路で構成される。図3のように 高周波加速空洞のインピーダンス Z1 とし、加速電圧を昇 圧するカップリング回路をトランスで模擬したLC共振回 路とすると、(1)の条件よりZ2 は直列共振回路、Z3 は並列 共振回路と定めることが出来る。



図1:橋絡T字型全域通過網回路



図2;シンクロサイクロトロンの周波数広帯域化特性

さて、図3のようにカップリング回路Z1のコイルをL0、 L1とし、加速ギャップに当たるコンデンサをC0、トラン スの結合定数kとすると、Z1は

$$Z_{1} = \frac{j \omega L_{s} \{1 - \omega^{2} L_{0} C_{0} (1 - k^{2})\}}{1 - \omega^{2} L_{0} C_{0}}$$
(2)

となり、(1)の条件から Z2、Z3 が求まる。さらに素子の 値 L1、C1、C1 、L2、L2 、C2 もそれぞれ求められる。

$$L_{1} = \frac{k^{2}R^{2}L_{0}C_{0}}{2L_{s}}, \quad C_{1}' = \frac{2(1-k^{2})L_{s}}{k^{2}R^{2}}$$

$$C_{1} = \frac{2L_{s}}{R^{2}}$$

$$L_{1} = \frac{2L_{s}}{R^{2}}$$

$$L_{2} = \frac{2L_{s}}{R^{2}}$$

$$L_{2} = \frac{L_{0}C_{0}}{R^{2}}$$

$$L_{2} = 4\kappa L_{s}, \quad L_{2} = 4(1 - \kappa)L_{s}, \quad C_{2} = \frac{4L_{s}}{4L_{s}}$$

ここで、理想的に結合定数 k を 1 として、再計算すると、 C1 ´、L2 ´ は消え、L1、L2 が求まる。

$$L_{1} = \frac{R^{2}L_{0}C_{0}}{2L_{s}}, \quad L_{2} = 4L_{s}$$
(4)

これらの結果は図3のように決まる。さらに、回路網の入出力電圧比が1のとき、周波数の値(初期値 ω_i 、終値 ω_f)は2つ導き出すことが出来る。

$$\omega_{f}\omega_{i} = \frac{1}{L_{0}C_{0}}, \frac{\omega_{f}-\omega_{i}}{\omega_{f}\omega_{i}} = \frac{2L_{s}}{R}$$
(5)

これらの式には、 ω と、Ls、L0、C0、Rの4つの変数が含 まれ、 ω の値とLsとL0の巻線比を定め、C0かRかを定 めれば、回路素子の値を全て決定することは出来る。しか し、シンクロサイクロトロンの高周波加速装置は設計中で あり、今回はサイクロトロンの運転周波数である 30 と 52MHzを選び、Rを180Ωとして、C0を80pFに合わせた。 また、電圧を昇圧するための巻線比は、今後の検討課題で あり、今はこれを1:1とした。すると回路素子は以下の 値となった。

$$L_{0} = L_{s} = 0.2\mu H, \quad C_{0} = 80 \ pF$$

$$L_{1} = 1.3\mu H, \quad C_{1} = 12.4 \ pF$$

$$L_{2} = 0.8\mu H, \quad C_{2} = 20 \ pF$$
(6)

さて、トランスの巻線比が1:1であり、単一の橋絡 T 回路の、入力電流 I に対する、出力電流 Is との比と加速周 波数との関係は図4のようになる。この図から分かるよう に 30MH z と 52MH z のところで電流が最大をとることを 示している。これは電圧の昇圧に対して、最大値も比例関 係にあるので、フィーダー過熱の問題は回避出来ない。従 って、複数の橋絡 T 回路を並列に使用して、電流を分散化 するような方法を考えなくてはならない。



図3;橋絡T字型全域通過網の内部構造



図4:橋絡T回路の入出力電流特性

3 実験

トランス巻線比1:1の橋絡T回路の周波数広帯域特性 を実験によって検証するために、弱電回路によるモデルを 製作し、各部のインピーダンス、電圧電流測定をおこなっ た。

さて、弱電回路によるモデルの回路素子は全てテフロン シートの上に設置して外部から絶縁し、銅板コンデンサと 巻線コイル、金属皮膜抵抗を使用した。トランスを模擬し たカップリング回路 Z1 は、透磁率が 8 であり、高周波損 失が少ないカーボニル鉄 Fe(CO)₅からなる、トロイダル コアにコイルを巻き、一方のコイルに加速電圧にあたるコ ンデンサを取り付けた。

また、この回路全体の抵抗は市販の増幅器とマッチング をとるために 50Ωの抵抗に対し、本来は 50Ωをとること が望ましいが、インピーダンス変換器を取り付けることで さらに大きな抵抗にすることが出来る。そこで、180Ωの 抵抗を回路網に組込んで、周波数特性がない、抵抗からな るインピーダンス変換器を取り付けた。 これらの回路網を製作した後は、全体のインピーダンス の値をベクトルインピーダンスメータを用いて測定した。 回路全体では50Ωになるように製作したが、実際に測定を 行うと周波数帯域内で若干値が抵抗値が小さくなり45Ω 弱になっていて、LC成分が含まれ、全体として無視でき なくなっていた。しかし、信号源の特性インピーダンス50 Ωの8割~9割の抵抗であり、測定に差し支える程の電力 の反射がおきると思われなかったので、測定をそのまま行 った。また、電圧測定は信号源のシンセサイザーとオシロ スコープを用いた。

さて、図5の入力側の電圧 V に対する出力電圧(図3: Lsの両端の電圧)特性や加速電圧(図3:C0の両端の電圧) 特性のようになり、どちらも計算と大きく異なる好ましく ない結果となった。図5で 40MH z と 70MH z で十分に電 圧が出力されており、一方で 30MH z では入力電圧 V の 70% と低めにあらわれており、全体として共振点が計算結 果より右にずれた形になっているようである。図6では 40MH z の手前のところで入力電圧 V の 60%の加速電圧が 得られており、この図の共振点の前後では加速電圧が得ら れていなかった。また、これら2つの図を比べると、明ら かに 50MH z に差が出ており、電力が十分に伝達されてい ないことが分かる。

出力電圧の共振点が異なり、計算結果と異なったのは、 回路網のいずれかのインピーダンスに LCR 成分が含まれ、 共振周波数が異なっていたという問題が考えられ、加速電 圧への電力が小さいのは入力側からみた Z1 はカップリン グ回路に対し、L 性が強くあらわれ、高周波では電力が伝 達されにくくなっていると考えられる。また、高周波で電 圧が小さく、出力側との差が顕著にあらわれているので、 上の問題に加えて、相互インダクタンスの寄与が小さく、 カップリング回路の間で電力が損失しているようにもみ える。これはカップリング回路のトロイダルコアの透磁率 が低く結合定数が 0.5 以下と小さくなっていることと、カ ップリング間の漏れ磁束がまだ大きいことが原因と考え ている。

一方、入力電流Iに対する、C0へ流れる電流との比と周 波数の関係については、図6のようになり、これも計算と 異なった結果となった。図のように共振点手前で増加した 後、急激に減少し、高周波に従い再び増加傾向になってい た。最大で入力電流Iの35%であり、帯域の終値では40% となっていた。また高周波に従い増加傾向にあった。 電流計算が異なっていたのは加速電圧の場合と同じ理由 と考えられる。



図5:橋絡T回路の出力電圧(図3:Lsの両端)特性



図6:橋絡T回路の加速電圧(図3:C0の両端)特性



図7:橋絡T回路の電流(C0に流れる電流)特性

4 結論

同じ巻線比のトランスを用いたカップリング回路の加 速電圧測定を行ったが、いずれも計算結果と異なる結果と なっていた。計算結果を再現するためには回路網各々のイ ンピーダンスの共振周波数を合わせた上で、Lsまでに含ま れる、寄生共振の原因となるLCR成分を減らすことであり、 また、相互インダクタンスの寄与を大きくするためにコイ ル接触不良の技術的な問題などを解決し、漏れ磁束を小さ くすることである。

今の段階では可能性があるかどうかは言えないが、今後 はこの回路の再度検証を行い、次段階では電圧を昇圧した 場合の、電流が分散化するような方法について追求したい。

謝辞

本論文を作成するにあたって、RCNPの加速情報研究部 の方の様々なご助言とご協力を頂きました。指導教官の佐 藤健次先生、助手の二宮史郎先生、技官の田村仁志先生に は物理的なものの考え方や実験のノウハウについて教え てくださいました。心から感謝致します。

参考文献

- [1] Joe Nakano : FFAG の開発とその応用について、KEK、 2002
- [2] 山本昌亘:修士論文、陽子シンクロトロン加速器用無 同調型高周波加速空洞の開発、阪大、1997